

НЕУПРУГАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ В МОНОДОМЕНИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ КРИСТАЛЛАХ ТАНТАЛАТА ЛИТИЯ

В.С. Горелик, С.Д. Точилин

В монодоменных кристаллах tantalата лития обнаружено резкое возрастание интенсивности рассеянного света (в 10^3 раз), обусловленное динамическими флуктуациями параметра порядка вблизи точки фазового перехода.

Проведено исследование температурной зависимости интенсивности неупругого и рэлеевского рассеяния света вблизи точки фазового перехода в кристаллах tantalата лития ($T_c = 898$ К). Интерес к такого рода экспериментам обусловлен обнаружением аномалий /1,2/ интенсивности неупругого рассеяния света в области фазового перехода в кристаллах подобного типа, связываемых с возрастанием динамических флуктуаций параметра порядка и размягчением кристаллической решетки /3/. До настоящего времени такие аномалии изучались в полидоменных кристаллах tantalата лития, что не позволяло осуществить однозначное разделение сигналов динамического типа и чисто статического рассеяния, обусловленного вкладом доменных стенок.

В настоящей работе проведены аналогичные исследования для монокристаллов tantalата лития, монодоменизированных небольшим по величине ($E = 10$ В/см) электрическим полем, приложенным вдоль полярной оси образца. Другая особенность методики состояла в использовании очень узких щелей двойного монохроматора ($0,3 \text{ см}^{-1}$), что обеспечивало высокую степень монохроматизации и возможность получения надежных сигналов неупругого рассеяния в области достаточно низких частот ($\sim 1 \text{ см}^{-1}$). Регистрация неупругого рассеяния света проводилась с помощью обычной техники /1,2/ на спектрометре ДФС-24 с использованием в качестве источника возбуждения аргонового лазера ILA-120 с мощностью линии генерации ($\lambda = 488,0$ нм) 1 Вт. Электрическое поле оставалось приложенным к образцу в процессе температурных измерений, которые выполнялись с точностью 0,1 градуса. Кристаллы нагревались со скоростью 0,5 град/мин. Запись температурной зависимости спектральной интенсивности рассеянного света осуществлялась на двухкоординатном потенциометре при фиксированных частотах спектрометра $\Omega = \omega_0 - \omega'$ (изочастотная методика). Здесь ω_0 и ω' – частоты возбуждающего и рассеянного света. Геометрия рассеяния $X(ZZ)Y$ выбиралась таким образом, чтобы основной вклад в неупругое рассеяние света был связан с по-перечной оптической модой A_1 -типа симметрии, "размягчающейся" вблизи точки сегнетоэлектрического перехода. Неупругое рассеяние изучалось для частот $\Omega \leq 40 \text{ см}^{-1}$. Для сравнения были проделаны исследования температурной зависимости интенсивности рэлеевского ($\omega' \cong \omega_0$) рассеяния в полидоменных образцах для девяностоградусного рассеяния.

На рис. 1 и 2 показаны полученные изочастотные зависимости соответственно для несмешенного по частоте (рэлеевского) и неупругого рассеяния света. Как видно из рис. 1, в области фазового перехода обнаруживается отчетливый максимум интенсивности. Для монодоменного образца он хорошо выражен в точке перехода; для полидоменного кристалла этот максимум наблюдается на фоне довольно сильного сигнала рассеяния, постепенно спадающего по мере приближения к критической температуре. Наличие пика интенсивности в точке перехода в монодоменном образце (кривая 2, рис. 1) позволяет утверждать, что он не связан со статическим рассеянием на доменных стенках.

Рис. 2 показывает каким образом этот максимум "трансформируется" по мере изменения частоты Ω при переходе к существенно неупругому рассеянию. С увеличением частоты Ω его интенсивность быстро уменьшается (вставка на рис. 2), а положение на температурной шкале постепенно смещается от точки перехода.

Таким образом, выполненные эксперименты с монодоменизованным электрическим полем кристаллом tantalата лития подтверждают сделанный ранее /2/ вывод о динамическом характере возрастания

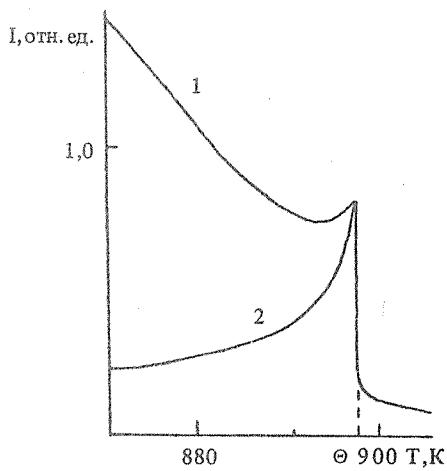


Рис. 1. Температурная зависимость интенсивности квазиупругого ($\Omega = 0 \pm 0,15 \text{ см}^{-1}$) рассеяния света в LiTaO_3 в нулевом поле (1) и в поле, достаточно сильном для монодоменизации низкотемпературной фазы (2).

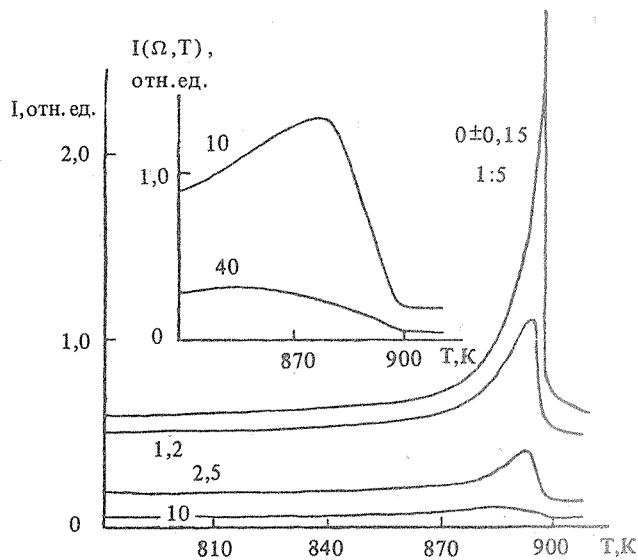


Рис. 2. Наблюдаемые изочастотные зависимости $I(\Omega, T)$ для танталата лития. Цифры у кривых – частоты в см^{-1} .

интенсивности рассеяния света вблизи сегнетоэлектрического фазового перехода в этом кристалле и свидетельствуют о проявлении в области наиболее низких частот в окрестности критической температуры эффекта неупругой низкочастотной опалесценции (ННО).

Для количественного описания этого эффекта при $T < T_c$ может быть использовано соотношение /3/:

$$i(\Omega, x) = \frac{\eta_0^2(x)}{(\Omega_R + s^2 K^2/\Gamma)^2 + \Omega^2}. \quad (1)$$

Здесь $i(\Omega, x)$ – приведенная спектральная интенсивность неупругого рассеяния /4/; K – волновой вектор колебания, рассеивающего свет; $x = T - T_c$; Ω_R – частота релаксации параметра порядка η_0 без учета пространственно-неоднородных флуктуаций; s – скорость соответствующих звуковых волн; Γ – коэффициент затухания мягкой моды. Соотношение (1) соответствует релаксационному приближению для мягкого колебания, хорошо описывающему реальную ситуацию при достаточно низких частотах Ω в окрестности фазового перехода. Для частот $\Omega \gtrsim 3 \cdot 10^{10} \text{ с}^{-1}$ величиной $s^2 k^2/\Gamma \sim 10^8 \text{ с}^{-1}$ в (1) можно пренебречь. При учете линейных зависимостей от x для величин η_0^2 и Ω_R , соответствующих приближению среднего поля для фазовых переходов второго рода, из (1) легко получить (см. также /3/) координаты максимума ННО:

$$i_0 \sim 1/\Omega, \quad x_0 = \Omega/B, \quad (2)$$

где коэффициент B определяется из соотношения $\Omega_R = Bx$ (температурная зависимость частоты релаксации параметра порядка).

В табл. 1 приводятся теоретические (согласно соотношению (2)) и экспериментальные значения величин i_0 и x_0 . Коэффициент B принимался $0,53 \text{ см}^{-2} \text{ град}^{-1}$, а его значение вычислялось для $\Omega = 10 \text{ см}^{-1}$ с использованием экспериментальной величины $x_0 = 18,7$ град. Теоретические и экспериментальные значения x_0 и i_0 были совмещены при $\Omega = 10 \text{ см}^{-1}$.

Таблица 1

Параметры зависимости $i(\Omega, x)$ в кристаллах tantalата лития

$\Omega, \text{ см}^{-1}$	$0 \pm 0,15$	1,2	2,5	5	10	25	40
$x_0, \text{ град}$	0	2,5	4,9	9,7	18,7	38,5	51,2
	теор.	0	2,2	4,7	9,3	18,7	46,7
$i_0, \text{ отн.ед.}$	$1,4 \cdot 10^4$	845	407	204	100	37	22
	теор.	∞	833	400	200	100	40

Как видно из табл. 1, экспериментальные и теоретические значения i_0 хорошо согласуются между собой во всей исследованной области частот. Экспериментальные значения x_0 близки к теоретическим при малых частотах и заметно отличаются при больших частотах Ω . Этот факт свидетельствует о необходимости учета частотной дисперсии параметров мягкой моды, которая появляется за счет ее взаимодействия с другими модами кристаллической решетки.

Таким образом, из анализа особенностей рассеяния света в монодоменых кристаллах tantalата лития следует, что аномалии интенсивности рассеяния в обсуждаемых условиях носят динамический характер и удовлетворительно описываются на основе известной теории неупругого рассеяния с учетом одной эффективной мягкой моды в релаксационном приближении. Представляет интерес анализ еще более низких частот $\Omega < 10^{10} \text{ с}^{-1}$ с целью выявления эффектов пространственной дисперсии (учет конечности значения волнового вектора к мягкой моды) и особенностей поведения параметра порядка в непосредственной близости от точки перехода.

ЛИТЕРАТУРА

- Горелик В. С. Труды ФИАН, 132, 16, (1982).
- Горелик В. С., Григорьев А. П., Сущинский М. М. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 14, 35 (1982).
- Горелик В. С. Изв. АН СССР, 49, 282 (1985).

Поступила в редакцию 10 марта 1986 г.